

مقاله نامه هفتمین کنفرانس ملّی خلاً ایران دانشگاه مازندران ۱۳۹۴ آبان ۱۳۹۴



# لايهنشانی ليزر پالسی لايه های نازک $(V_2O_5)_x (V_2O_5)$ :ساخت، مشخصهيابی و بررسی

# خواص فوتوكروميكي

اشرفی، محمدامین؛ رنجبر، مهدی؛ عبدالحسینی، اسماعیل؛ سلامتی، هادی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان، ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱

## چکیدہ

در این پژوهش لایههای نازک ترکیبی<sub>x</sub>(V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)<sub>x-1</sub> (MoO<sub>3</sub>)با نسبتهای ترکیبی مختلف(۲۲۹ و ۷/۲۷ و ۲=x) به روش لایه نشانی لیزر پالسی با انرژی ۲۰۰ میلی-ژول بر روی زیرلایه شیشه، فشار جزیی اکسیژنو در دمای اتاق تهیه شدند. سپس لایههای ایجاد شده تحت عملیات حرارتی در دمای <sup>0</sup> ۵۰۰ به مدت ۴ ساعت در هوا قرار گرفتند. ویژگیهای ساختاری،اپتیکی و مورفولوژی سطح با استفاده از آنالیزهای FE-SEM XRD و اسپکتروسکوپیUV/VISطالعه شد. نمونه اولیه آمورف بوده و پس از پخت، XRD تشکیل ساختار کریستالی اکسید مولیدن و اکسید وانادیوم در فاز اورتورمبیکرا نشان داد. با استفاده از آنالیز مای ۲۰۱ آلایش ۲۰۲۹ بعد تابش UV تشکیل ساختار کریستالی اکسید مولیدن و اکسید وانادیوم در فاز اورتورمبیکرا نشان داد. با استفاده از آنالیز ۲۰۱۷ تاریش به ۲۰۲۹ ترانستیم ضخامت لایه را ۲۰۰ اندازه گیری کنیم. بررس های فوتوکرومیکی لایه از تحت تابش UV نشان داد که با افزایش آلایش تا میزان ۲۱۷۰، تغییر عبور لایهها در دو حالت رنگی و شفاف افزایش یافته است.در آلایشهای بیشتر از ۱۷/۱۰ین تغییرات کاهش یافت.

# Pulsed laser deposition of $(MoO_3)_{1-x}$ $(V_2O_5)_x$ composite thin films: preparation , characterization and photochromic properties studies

#### Ashrafi, M.Amin; Ranjbar, Mehdi;Abdolhosseinisarsari,Ismaeil; Salamati, Hadi Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan, 8415683111 Abstract

In this work, mixed oxide thin films of  $(MoO_3)_{1-x}$   $(V_2O_5)_x$  (x=0, 0.17, and 0.29) were fabricated by pulsed laser deposition (PLD) method at oxygen partial pressure, on glass substrates and at room temperature. Deposited samples were then annealed at 500 °C for 4 hours in air. Structural, chemical and optical properties were characterized by following methods, XRD, UV-Vis spectroscopy and FE-SEM. XRD confirmed the amorphous to orthorhombic structural transformation for  $MoO_3$  and  $V_2O_5$ after annealing. From the cross-sectional FE-SEM images, the thickness of the prepared thin film (x=0.29) was measured to be about 700 nm. Photochromic investigations by UV irradiation revealed that the optical transmission difference increases with x up to 0.17 then decreases at high values of x.

شیشههای هوشمند میباشد. همچنین کاربردهای اپتیکی مانند عینکهای فوتوکرومیک،شیشههای فوتوکرومیک در صنعت خودرو و غیره میتواند حاکی از اهمیت هرچه بیشتر این ترکیبات باشد[۱].تاکنون ترکیبات مختلفی از قبیل O-V-W و O-TWاز

امروزه استفاده بهینه از انرژی باتوجه به نیاز روزافزون در دنیا بسیار مورد توجه محققان و دانشمندان قرار گرفته است، از جمله روش-های مفید برای افزایش بهرهوری در مصرف انرژی استفاده از

مقدمه



## مقاله نامه هفتمین کنفرانس ملّی خلأ ایران دانشگاه مازندران ۱۳۹۴ آبان ۱۳۹۴

بااتانول،التراسونیک و آب IDتمیز شدهاند. برای لایه نشانی از سیستم PLDکه به صورت طرحوار در شکل ۱ آورده شده است،با استفاده از لیزر Excimer باطول موج ۲۴۸nm، همچنینقرصهای پرس شده ی  $(V_2O_5)_{x-1}(MoO_3)$ با نسبتهای مشخص (۲۹،، استفاده از روش تف-یرس ، بازیخت و در دمای  $\Omega^{\circ}\Omega$ به مدت ۱۲h تهیه شدند. لایه-نشانی درفشار محفظه Torr^-۱×۱،

درحضور گاز اکسیژن با فشار Torr<sup>۱-۱</sup>۲۰۳ با انرژی بر پالس ۲۰۰mJ و آهنگ رشد حدود ۳۰۰ Å/min و در دمای اتاق انجام شده است.



شکل ۱. نموداری کلی از سیستم لایهنشانی، سیستم خلأ و محفظه آن

با توجه به ساختار اولیه آمورف لایههاو به منظور بررسی ساختاری، لایهها به مدت fh در دمای  $0.0^\circ$  بازپخت شدند. ساختار بلوری نمونهها توسط دستگاه پراش پرتو ایکس(XRD) با طول موج Å/۱/۵۴۶۹ از چشمه  $CuK_{\alpha}$ مدل(XPERT)استفاده شد.همچنین مورفولوژی سطح لایههای نازک و ضخامت آنها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی(FE-SEM) مدل TESCAN-MIRA3بررسی شد. ویژگیهای اپتیکی نمونهها با استفاده از دستگاه طیفسنج اپتیکی Sulv-Vis مدل UV-Vis با استفاده از دستگاه طیفسنج اپتیکی قرار گرفت. جهت این ویژگیهای اپتیکی مورد بررسی قرارگرفتهاند [۲, ۳]، لذاافزایش بهر،وری این ترکیبات از جمله اهدافی است که توجه محققان را به خود جلب کرده است. اکسید فلزات واسطه به دلیل ویژگیهای ذاتی که دارند میتوانند گزینههای مناسبی برای این دسته از کاربردها باشند.در پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه ویژگیهای دیگری از جمله رفتارهای حسگری از این ترکیبات گزارش شده است، کاربردهای گسترده حسگرها توجیه مناسبی برای پژوهش روی این ترکیبات و افزایش بهر،وری آنها را فراهم میآورد.

در این پژوهش سعی داریم تا با استفاده از اکسیدهای ترکیبی، شامل اکسید مولیبدن و اکسید وانادیوم لایههای نازکی با خواص اپتیکی و ویژگیهای فیزیکی بهبودیافته بدست آوریم. براساس مقالات، افزایشمیزان وانادیوم اکساید میتواند تغییرات چگالی اپتیکی را برای ترکیباتV-V-W بهبود بخشد[۳]، همچنین اکسید مولیبدن در حالت لایه نازک خاصیت فوتوکرومیک قابل قبولی از خود نشان میدهد[۴]. روشهای مختلفی مانندکندوپاش، سل-ژل، لایهنشانی تبخیر شیمیایی و لایهنشانی لیزر پالسی[۳]برای ساخت روش لایهنشانی لیزر پالسی(PLD) که امکان حفظ استوکیومتری و همچنین کنترل دقیق بر روی ضخامت لایه را برای ما فراهم می-آورد بتوانیم این ویژگی را بهبود بخشیم و به نوعی خواص اپتیکی بهبود یابد.

به منظور بررسی ساختاری با توجه به اینکه لایههای ایجاد شده در دمای اتاق، آمورف هستند، لازم است تا با استفاده از عملیات حرارتی در دماهایی بالاتر از 2°۵۰۰ که موجب تأثیر بر روی اندازه بلورکها و ساختار کریستالی لایهها میشود، عیوب ساختاری کاهش یابد و بتوانیم ساختار کریستالی را مورد بررسی قرار دهیم[۵, ۶].

# نحوه انجام آزمايش

در این مقاله، از زیرلایههای شیشهای نازک (Corning) جهت لایهنشانی استفاده شده است. قبل از لایهنشانی، زیرلایهها



نتايج و بحث

### مقاله نامه هفتمين كنفرانس ملّى خلأ ايران دانشگاه مازندران ۲۰و۲۱ آبان ۱۳۹۴

است، همچنین با توجه به اطلاعات ثابت شبکه کارت استاندارد MoO<sub>3</sub> (۵۰۸–۰۰۰–۰۰۰) که در شکل ۱ آورده شده است، بیانگر ساختار اورتورمبيک ميباشد. برای آلایش x=۰/۱۷ اندازه پارامتر شبکه در راستای b به کمترین

میزان خود رسیده است، به عبارتی می توان این گونه بیان کرد که ساختار MoO<sub>3</sub> بر ساختار V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> غالب می شود و وانادیوم در ساختار موليبدن اكسايد جانشاني شده است.

جدول ۱. ثایتهای شبکه محاسبه شده با استفاده از نرمافزار MAUD، اندازه بلورک محاسبه شده از طریق رابطه Scherrer برای هر سه آلایش و پارامترهای

نمونه	ثابتشبكه			D (nm)
	а	b	С	
x= •/•	3443	17/1919	3/6290	۵٧/٣
$x = \cdot / V$	37/9147	۱۳/۶۸۷۹	36644	۲۳/۴
x= •/۲٩	37/9479	۱۳/۸۳۱۰	٣/۶л4.	۵۵/۴
••-••۵-•۵•٨	٣/٩۶٢.	13/2020	۳/۶۹۷۰	

شبکه برای کارت استاندارد MoO<sub>3</sub>

با استفاده از رابطه شرر:

 $D = \frac{0.9\lambda}{\beta \cos\theta}$ 

که در آن  $\lambda$  طول موج، eta نیم پهنای قله پراش، heta زاویه پراش براگ و D اندازه بلورک است، توانستیم اندازه بلورکهای تشکیل دهنده لایههای نازک را بدست آوریم که برهمین اساس اندازه بلورکها در جدول۱ مشاهده می شود. همانطور که مشخص است برای آلایش ۱۷/۰ کمترین اندازه دانه بدست میآید که در ادامه، تصاویر FE-SEM همين ادعا را ثابت مي كنند.

(1)

با توجه به تصاویر FE-SEM گرفته شده مشخص است که با گذر از تصویر (b) به (a) میزان تخلخل کاهش مییابد و به نوعی افزايش آلايش موجب كوچك شدن اندازه بلورك و افزايش تخلخل شده است.این تصاویر نتایج حاصل از محاسبه اندازه بلورک شرر و روند کلی ذکر شده در جدول ۱ را تأیید می کند.

طیفهایXRDدر شکل ۱به لایههای نازک با سه آلایش مورد نظر یس از عملیات حرارتی مربوط می باشند.

بر اساس این الگوهای پراش و با توجه به کارتهای استاندارد ساختار (۲۰۶۰×-۰۰۰)و MoO<sub>3</sub>) ساختار (۱۰۵۰–۰۰۰) ساختار اورتورومبيک MoO<sub>3</sub>در حالت آلايشصفر و همچنين رشد ساختار V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> با افزایش آلایش، مشاهده می شود.

با توجه به شکل۲ قلههای اصلی MoO<sub>3</sub> و V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> مشاهده می-شوند که نشاندهنده ساختار اورتورمبیک می باشد. با افزایش درصددV2O5 و رسیدن به آلایش حداکثری شدت قلههای مربوط به ساختار اکسید وانادیوم در راستای (۲۰۰) ، (۰۱۰) و (۳۱۰) بیشترین رشد را از خود نشان میدهد که برخی از این صفحات در MoO3 نیز در همان موقعیت مشاهده می شود که شاید به جانشانی وانادیوم در جایگاههای مولیبدن مربوط باشد.



شكل۲. الگوهای پراش پرتو ایكس لایههای نازک بازپخت شده با آلایش  $x = \cdot / \Upsilon (d) x = \cdot / \Upsilon (c) x = \cdot (b) x = \cdot before annealing(a)$ 

با استفاده از نرمافزار MAUD و اطلاعات بدست آمده از XRD ثابت شبکه را برای نمونهها محاسبه کردیم که نتایج آن در جدول۱ مشاهده می شود.

با استفاده از نتایج بدست آمده از جدول۱ مشاهده می شود که ثابتهای شبکه در راستای b برای همه نمونهها بشترین مقدار



مقاله نامه هفتمین کنفرانس ملّی خلأ ایران دانشگاه مازندران ۱۳۹۴ آبان ۱۳۹۴





شکل۳. تصاویر FE-SEM از نمونه های ۲۹۰ (a)، x=۰ (b) و سطح مقطع نمونه ۲۹-(c).

در قسمت (C) شکل۳ ضخامت لایه برای آلایش ۰/۲۹ به میزان ۷۰۰nm اندازه گیری شده است.

طیف های عبور اپتیکی نمونه ها قبل و بعد از تابش نور UV در شکل ۴ نشان داده شده است. با توجه به طیف های عبوری در شکل ۴ به وضوح مشاهده می شود که با تابش نور UV میزان عبور لایه ها کاهش می یابد و رنگی می شوند و در آلایش ۱۰/۷ این مقدار بیشینه است.در مورد نمودار (a) که به نمونه بدون آلایش مربوط می شود، اختلاف بین حالت شفاف و رنگی بسیار بیشتر است ولی میزان عبور در مجموع کمتر است و این رفتار، مطلوب کاربردهای فوتو کرومیک نیست.

## نتيجه گيرى

PLD با روش (MoO<sub>3</sub>)<sub>1-x</sub>(V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)<sub>x</sub> با روش (MoO<sub>3</sub>) با روش ساخته شد. به منظور بررسی خواص ساختاری، ریختشناسی و اپتیکی آنالیزهای XRD، FE-SEM و اسپکتروسکوپی VVVis گرفته شدند. نتایج XRD ساختار اورتورمبیک را به ما نشان داد و همچنین با استفاده از رابطه (۱) اندازه بلورکها در محدوده محینین با استفاده از رابطه (۱) اندازه بلورکها در محدوده ۲۳–۵۷nm توانستیم ثابتهای شبکه را بدست آوریم و ساختاری نزدیک به ساختار MOO<sub>3</sub> را تأیید کنیم. تصاویر FE-SEM مورفولوژی متخلخلی را

نشان میدهند که با افزایش آلایش این تخلخل نیز افزایش یافته است. طیف اپتیکی نمونهها با استفاده از آنالیز اسپکتروسکوپیUV/Vis انجام گرفت که افزایش تغییرات عبور با افزایش آلایش و همچنین حالت بهینه آنرا برای آلایش ۲۷/۱۷ نشان داد.



شکل۴. طیف عبوری لایههای نازک قبل و بعد از تابشUVبه مدت ۴h. x=۰/۲۹(c) ،x=۰/۱۷ (b) ،x=۰(a) (b) ،x=۰(a)

مراجع

- 1. Granqvist, C.G., *Handbook of inorganic electrochromic materials*. 1995: Elsevier.
- 2. Somasundaram, S., et al., Composite  $WO_3$ -Ti $O_2$  films: Pulsed electrodeposition from a mixed bath versus sequential deposition from twin baths. *Electrochemistry communications*, 2006. **8**(4): p. 539-543.
- Ranjbar, M. and S. Mahdavi, Pulsed laser deposition of W–V–O composite films: preparation, characterization and gasochromic studies. *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 2008. 92(8): p. 878-883.
- Rao, M., et al., Structural stoichiometry and phase transitions of MoO<sub>3</sub> thin films for solid state microbatteries. *Research Journal of Recent Sciences* 2013. 2277: p. 2502.
- 5. Alam, M. and D. Cameron, Investigation of annealing effects on sol-gel deposited indium tin oxide thin films in different atmospheres. *Thin Solid Films*, 2002. **420**: p. 76-82.
- Kandasami, A., G. Khan, and B.A. Bhat, Role of substrate effects on the morphological, structural and transport properties of V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> thin Films. *RSC Advances*, 5;(2015) 52602-52611